

0. 真空中に内径  $a$ 、外径  $b$  の球殻があり、電荷  $Q$  が一様に分布している。

- (1) 電荷密度  $\rho(\mathbf{r})$  を求めよ。
- (2) これによって生じる電場  $\mathbf{E}(\mathbf{r})$  を求めよ。

ヒント：電荷分布は原点を中心として球対称であることに留意せよ。

1. 真空中に内径  $a$ 、外径  $b$  の無限に長い円筒があり、単位長さあたり  $\lambda(> 0)$  の電荷が一様に分布している。これによってできる、電場  $\mathbf{E}(\mathbf{r})$  を求めよ。

ヒント：電荷分布は円筒の軸を中心として回転対称であることに留意せよ。

2. 静電ポテンシャルが原点を中心として球対称、すなわち  $\phi(\mathbf{r}) = \phi(r)$  ただし  $r = |\mathbf{r}|$  と表せるとする。このときの電荷の分布を考える。定義から電場は  $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla\phi(\mathbf{r})$ 、また Maxwell 方程式より電荷密度は  $\rho(\mathbf{r}) = \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r})$  である。

- (a) 電場は  $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r)\hat{\mathbf{r}}$  のような形で表せることを示せ。
- (b) 電荷密度は  $\rho(\mathbf{r}) = \rho(r) = \epsilon_0 \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr}(r^2 E(r))$  と表せることを示せ。
- (c) 原点を中心とする内径  $a(> 0)$ 、外径  $b(> 0)$  の球殻状の領域に含まれる電荷量を  $Q(a, b)$  とする。  $Q(a, b) = 4\pi\epsilon_0 [b^2 E(b) - a^2 E(a)]$  となることを示せ。  
(ヒント：(b) の結果を体積積分)
- (d) 原点を中心とする半径  $r$  の球の内部を  $V(r)$  とする。  $V(r)$  に含まれる電荷の総量を  $Q(r)$  とする。  $Q(r) = 4\pi\epsilon_0 r^2 E(r)$  となることを示せ。(ヒント：ガウスの発散定理)
- (e) 具体的に

$$\phi(r) = \frac{q_0 e^{-kr}}{\epsilon_0 r}$$

の場合を考えてみる。ただし、 $k > 0$  とする。この場合に  $\lim_{b \rightarrow \infty} \lim_{a \rightarrow 0} Q(a, b)$ 、 $Q(0)$ 、 $Q(\infty)$  を求めてみよ。矛盾がないか議論せよ。

3.  $N$  個の電荷  $i = 1, 2, \dots, N$  の電荷を  $q_i$ 、位置ベクトルを  $\mathbf{r}_i(t)$ 、速度ベクトルを  $\mathbf{v}_i(t)$  とする。電荷密度および電流密度は

$$\rho(\mathbf{r}, t) = \sum_{i=1}^N q_i \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i(t)) \quad \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \sum_{i=1}^N q_i \mathbf{v}_i(t) \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i(t))$$

と表せる。

(a) 上の  $\rho(\mathbf{r}, t)$  および  $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t)$  の定義式に基づき、これらが連続の式

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{j}$$

を満たしていることを示せ。 $\mathbf{v}_i(t) = d\mathbf{r}_i(t)/dt$  に注意せよ。

(b) (a) の結果から、ある閉じた領域  $V$  に含まれる全電荷  $Q(t)$  の時間変化は

$$\frac{dQ(t)}{dt} = -\int d\mathbf{S} \cdot \mathbf{j}$$

と表せることを示せ。ただし右辺の面積分は、領域  $V$  を囲む表面とする。